

单向可控硅

MCR100-8 (TO-92)

MCR100-8 (TO-92)单向可控硅

n 特点:

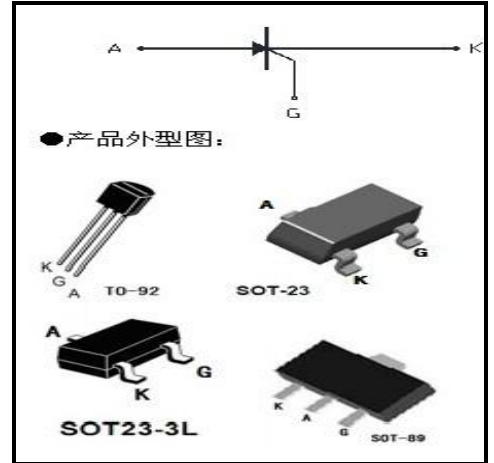
先进的玻璃钝化芯片、具有灵敏的控制极触发电流， I_{GT} 一致性好，耐电流冲击能力强，通态压降低。

n 用途:

广泛应用于各种万能开关器、小型马达控制器、彩灯控制器、漏电保护器、灯具继电器激励器、逻辑 集成电路驱动、大功率可控硅门极驱动、摩托车点火器等线路功率控制。

n 极限参数:

名称	符号	规范值	单位	测试条件
重复峰值阻断电压	V_{DRM}	>600	V	$I_{DRM}=20\mu A$
反向重复峰值电压	V_{DRM}	>600	V	$I_{RRM}=50\mu A$
通态电流	$I_{T(RMS)}$	1.0	A	----
浪涌电流	I_{TSM}	12	A	$F=50HZ$ $t_p=10ms$
结温	T_j	-40~110	°C	----
储存温度	T_{stg}	-40~150	°C	----



n 电特性 ($T_c=25^\circ C$):

名称	符号	测试条件	Min	Max	单位
重复峰值阻断泄漏电流	I_{DRM}	$V_D=V_{DRM}$ $T_c=110^\circ C$	----	100	μA
通态电压	V_{TM}	$I_T=2A$ $t_p=380\mu s$	----	1.7	V
门极触发电流	I_{GT}	$V_D=12V$, $I_T=0.1A$	----	200	μA
门极触发电压	V_{GT}	$V_D=12V$, $I_T=0.1A$	----	0.8	V
门极不触发电压	V_{GD}	$V_D=V_{DRM}$ $T_j=110^\circ C$ $R_L=3.3K\Omega$	0.1	----	V
断态电压临界上升率	dv_D/dt	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ Gate open $T_j=110^\circ C$	10	----	$V/\mu s$
擎住电流	I_L	$I_g=1.2I_{GT}$	----	6	mA
维持电流	I_H	$I_T=50mA$	----	5	mA